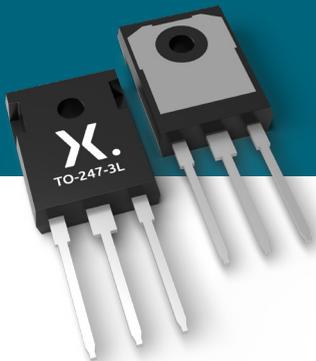


> 650 V IGBT

适用于工业应用



为满足对高效、高电压功率变换和电机驱动日益旺盛的需求，Nexperia的IGBT采用先进的载流子储存沟栅(CSTBT)场截止(FS)工艺。它为工业应用带来了高可靠性的同时，还提高了功率密度。

设计优势

- > 低导通和开关损耗
- > 高可靠性
- > 稳定且精准的参数，便于并联运行
- > 最高结温为175
- > 全额软快速反向恢复二极管
- > 5 μ s短路能力（针对M3）
- > 可实现出色的系统效率和可靠性

主要技术特性

- > 超低二极管Vf
- > 超低IGBT关断损耗
- > 可权衡总功率损耗



关键应用

- > 工业电机驱动，尤其是5 <-> 20 kW (20 kHz) 伺服电机
 - 机器人、电梯、机器操作手、工业自动化
- > 功率逆变器
 - 不间断电源(UPS)
 - 光伏(PV)串联组件
 - EV充电
- > 感应加热、焊机

650 V产品

红字所示产品正在开发中

型号	Tc=100°C时的电压/电流	IGBT类型	Copak 二极管额定值	SCWT	封装	发布日期
NGW40T65M3DFP	650 / 40	MS	完全额定值	5μs	 TO-247-3L	2024年6月
NGW50T65H3DFP	650 / 50	HS				
NGW75T65H3DF	650 / 75	HS				
NGW30T65M3DFP	650 / 30	MS				Q1 2025
NGW50T65M3DFP	650 / 50	MS				
NGW60T65M3DFP	650 / 60	MS				
NGW75T65M3DFP	650 / 75	MS				
NGW40T65H3DFP	650 / 50	HS				
NGW75T65H3DFP	650 / 75	HS				

© 2024 Nexperia B.V.

保留所有权利。未经版权所有者优先书面同意，禁止复制本文全部或部分内容。本文档中所提供的信息不构成任何报价或合同的一部分，且被认为是准确可靠的，如有变更，恕不另行通知。对于使用本文档所产生的任何后果，出版方概不承担任何责任。出版内容既不传达也不暗示专利或者其他工业或知识产权下的任何许可。

发布日期：
2024年7月